

國立中興大學技術授權遴選廠商公告資料表

公告主旨：國立中興大學技術移轉遴選廠商公告	公告日期：108/04/19
公告編號： 108-016	
<p>內容：國立中興大學技術移轉遴選廠商公告</p> <p>一、技術名稱：固態發光結構的製造方法</p> <p>二、專利資訊：I493755</p> <p>三、技術來源：經濟部</p> <p>四、技術內容：</p> <p>一種固態發光結構的製造方法，先在第一基板上形成氮化鎵系材料無法磊晶成長的犧牲層，再移除部分犧牲層的結構得到圖案化的犧牲層結構；然後以朝三維方向成長的磊晶生長自第一基板的預定區域形成由氮化鎵系材料構成的第一半導體結構、以朝橫向成長速度較快的磊晶生長自第一半導體結構向上形成第二半導體層、和由第二半導體層向上成長供電時發光的發光晶體層；在發光晶體層表面接合上第二基板後移除犧牲層結構形成蝕刻通道，再經由蝕刻通道移除第一基板、第二半導體層後，即製得連結在第二基板與發光晶體層的固態發光結構。</p>	
<p>五、計畫執行機關/系所：材料科學與工程學系、精密工程研究所</p> <p>技術發明人：武東星、洪瑞華、潘俊廷教授</p>	
<p>六、廠商資格：</p> <p>1、廠商業別：光電產業</p> <p>2、應具備之專門技術：磊晶技術、LED 元件製程技術</p> <p>3、應有之機具設備：有機金屬氣相磊晶反應設備、黃光微影設備、金屬蒸鍍/濺鍍設備、化學蝕刻設備等</p> <p>4、應有之研究或技術人員人數：10人</p> <p>5、其他：無</p>	
<p>七、預期利用範圍及產品：發光二極體、LED 顯示陣列晶片、顯示器...等光電產品。</p>	
<p>八、公開方式：</p> <p>(一) 技術資料於網際網路上公開。</p> <p>網址：國立中興大學首頁 http://www.nchu.edu.tw/index1.php</p> <p>國立中興大學產學研鏈結中心 http://140.120.49.189/about1.php</p> <p>(二) 逕向國立中興大學產學研鏈結中心葉小姐及黃小姐索取相關資料。</p>	
<p>九、申請方式：</p> <p>(一) 由網際網路下載申請表格，填妥後逕送至國立中興大學產學研鏈結中心。</p> <p>(二) 亦得逕至中興大學索取技術資料及申請表格。</p> <p>地點：台中市興大路145號（國農中心大樓2F 234室）</p> <p>承辦人員：葉小姐/黃小姐 聯絡電話：(04)22851811#21.20 傳真：(04)22851672</p> <p>e-mail：jmine3388@nchu.edu.tw、yenling@nchu.edu.tw</p>	